⑩ 日本国特許庁(JP) ⑩特許出願公開·

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-10256

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月17日

G 03 G 5/06

371

6906-2H

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全12頁)

60発明の名称 電子写真感光体

> 20特 顧 平1-146008

22出 願 平1(1989)6月7日

70発明者 木 昭

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

79発 明者 廣 瀬 尚 弘 個発 明者 雅

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

79発 抍 明彦

コニカ株式会社

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

1. 発明の名称

電子写真感光体

の出 願 人

2. 特許請求の範囲

(1)Cu-Xα線に対するX線回折スペクトルが、ブ ラック角 2 θ の 6.5° ± 7.5°の 領域に ブロード なピ ークを示すアモルファス状の結晶状態において、 塩素含有量が0.2重量%以下のチタニルフタロシ アニンを含有してなる電子写真感光体。

(2)前記チタニルフタロシアニンが、下記一般式 [[]で表されるチタン化合物を用いる方法によっ て製造された請求項1に記載の電子写真感光体。

一般式(1)

$$X_4 - X_1 - X_2 \cdot (Y)n$$

〔式中、X1、X2、X3、X4は-OR1、-SR2、-OSO2R3

ここでR:~Rsは、水素原子、アルキル基、アル

ケニル基、アリール基、アラキル基、アシール基、 アリロイル基、複素環基を表し、これらの基は任 意の置換基を有していてもよい。又、X1~Xeは任 **館の組合わせによって結合し、環を結成してもよ** い。Yは配位子を表し、nはO、1、2を表す。) (3)前記チタニルフタロシアニンがキャリア発生 物質として用いられる請求項1又は2のいづれか に記載の電子写真感光体。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子写真感光体に関するものであり、 特にプリンタ、複写機等に有効に用いることがで き、半導体レーザ光及LEDに対して高感度を示す 電子写真感光体に関するものである。

〔従来技術〕

電子写真感光体としては、古くからセレン、酸化 亜鉛、硫化カドミウム等の無機光導電物質を主成 分とする感光層を設けた無機感光体が広く使用さ れてきたが、このような無機感光体は例えば、セレ ンは熱や指紋の汚れ等によって結晶化するために

特性が劣化しやすく、硫化カドミウムは耐湿性、耐久性に劣り、酸化亜鉛も又耐久性に劣る等の問題があって、近年は種々の利点を有する有機光導電性物質が広く電子写真感光体に用いられるようになってきた。なかでもフタロシアニン化合物は光電変換の量子効率が高く、又近赤外線領域まで高い分光感度を示すため、特に半導体レーザ光源に適応する電子写真感光体用として注目されてきた。

そのような目的に対して、銅フタロシアニン、 無金属フタロシアニン、クロルインジウムフタロシアニン、クロルガリウムフタロシアニンなどを 用いた電子写真感光体が報告されているが、近年 特にチタニルフタロシアニンが注目されるように なり、例えば特開昭 61-239248号、同 62-670943号、 同 62-272272号、同 63-116158号のようにチタニル フタロシアニンを用いた電子写真感光体が多く技 術聞示されている。

一般に、フタロシアニン化合物は、フタロジニトリルや1,3-ジイミノイソインドリンなどと金属化合物を反応させて製造されるが、電子写真感光

-3-

には、フタロシアニン核の塩素反応が伴われる。 その上従来の製造法においては180℃以上の高温 度条件を必要とするために塩素化の副反応をチタニ ルフタロシアニンには、かなりの量の塩来のチチニ ニルフロシアニンの含有は避けられず、又量でなり、 エルフロシアニンの含有は避けられず、又量でなり、 チタニルフタロシアニンと物理的、化学の が類似しているため、再結晶や昇率精製にの さえ殆ど除去不能であり、従来、電子写文は塩 では、かなりのよば上が変化が されたチタニルフタロシアニンは に用いられていたチタニルフタロシアニンは に用いるためであった。例えば上での製造 の と、で、で、で、で、の、の、の、の、の、製造 の、で、で、なる。



体用のチタニルフタロシアニンの製造においては、 反応性の点で専ら四塩化チタンが原料として用い られてきた。例えば、チタニルフタロシアニンに 構造の類似したパナジルフタロシアニンの製造に おいては塩化パナジルや、パナジルアセチルアセ トネイトなどが原料として使用可能であるが、チ タニルフタロシアニンの製造においてはチタニル アセチルアセトネイトを原料として用いると収率 が著しく低下し、純度もまた低下する。このため、 電子写真感光体用のチタニルフタロシアニンの製 遺法としては、上述の特開昭61-239248号、同62-670943号、同62-272272号、同63-116158号の他に も、特開昭61-171771号、同61-109056号、同59-166959号、同62-256868号、同62-256866号、同62 -256867号、同63-80263号、同62-286059号、同63 -366号、同63-37163号、同62-134651号に開示さ れているがこれらの全ての場合において四塩化チ タンを用いた方法がとられている。

(発明が解決しよとする問題点)

前記のようなチタン塩化物を原料に用いた場合

-4-

車	1

		# 1		
. 公開公	報	C4の元素分析値 (wt%)	Mass スペクトル	
特開昭61-109056号	化合物 1	0.49	_	
	化合物 2	0.5	· _	
	化合物3	5	- .	
特開昭61-171771号	実施例1	0.87	-	
	実施例2	0.92	_	
	実施例3	0.87	· <u> </u>	
特開昭62-67094号	製造例 1	0.49	-	
	製造例4	0.85	-	
特開昭62-256865号	実施例1	0.43	-	
特開昭62-256866号	実施例 1	0.38	_	
特開昭62-256867号	実施例 1	0.60	-	
特開昭63-80263号	製造例1	0.43	_	
	製造例2	0.60	_	
	製造例3	0.58	-	
特開昭63-366号	実施例]	0.58	·	
特開昭63-37163号	A型製造例	0.43	_	
	B型製造例	0.60	_	
特開昭61-217050号	製造例	-	₩*=610を含む	
特開昭61-239248号	製造例	_	**-610を含む	

(注)M+=610は一塩素化チタニルフタロシアニンに対応する。

このように従来のチタニルフタロシアニンにお

-6-

いては 0.4 v t X 程度の 塩素の含有は避けられないものであった。 塩素原子としての 0.4 v t X という値は、一塩素化チタニルフタロシアニン濃度に換算すると7.0 v t X (6.6 モル X)の含有量に相当するものであり、不純物濃度としては非常に高い値である。

一方、フタロシアニン化合物の電子写真特性は、その結晶状態によって著しく異なり、チタニルフタロシアニンにおいても特定の結晶型を有するときに優れた特性が得られることが知られている。このうよに構造敏感な性質を持つ電子写真材料において、不純物の存在は構造的な欠陥部位を導入することになり、特定の結晶型の持つ優れた電子写真特性を損わせる原因となるものである。

そのような点に関して、我々は高純度のチタニルフタロシアニンを得るべく鋭意検討を行った結果、塩素化反応を伴わない製造法を適用することに成功し、そうして得られた塩素含有量の少ないチタニルフタロシアニンを特定の結晶構造にすることによって、優れた電子写真感光体を作成することができたものである。

-7-

スタート角度	6.0	deg.
ストップ角度	35.0	deg.
ステップ角度	0.02	deg.
濒 定 時 間	0.50	sec.

塩素含有量は通常の元素分析測定によっても決定されるが、三菱化成社製塩素・硫黄分析装置「TSX-10」を用いた元素分析によって決定することもできる。

本発明において最も望ましい塩素含有量としては、これらの測定方法において、検出限界以下となるものである。

本発明のチタニルフタロシアニンは下記一般式 (I)で要されるチタン化合物を用いることによって、塩素化を伴わずに、高純度で製造することが できる。



(発明の目的)

本発明の目的は、高感度にしてかつ残留電位が小さく、電位特性が安定している優れた電子写真感光体を提供することにある。

本発明の他の目的は、特に電位保持能に優れ、帯電電位の安定した電子写真感光体を提供することにある。

(発明の構成及び作用効果)

本発明の上記の目的は、Cu-K a 線に対する X 線回折スペクトルがブラッグ角 2 0 の 6.5° ± 7.5にピークを示すアモルファス状の結晶状態であって、かつ塩素の含有量が 0.2 v t % 以下、好ましくは 0.1 v t % 以下のチタニルフタロシアニンを感光層中に含有させることによって達成することができる。

X線回折スペクトルは次の条件で測定され、前 記ピークとは、ノイズと明瞭に異なった鋭角の突 出部のことである。

X 線	管球	Cu		
電	匥	40.0	K A	
電	流	100	m A	

-8-

一般式〔1〕

ここで、R:~R.は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、アシール基、アリロイル基、複素環基を表し、これらの基は任意の置換基を有してもよい。又X:~X,は任意の租合せによって結合し、環を形成してもよい。

Y は、配位子を表し、nは 0、1、2 を表す。なかでも特に X, ~ X, が - OR, であるものは、反応性や、取扱い易さ、価格などの点で、望ましいものとして挙げることができる。

製造方法としては種々の反応形式が可能であるが、代表的な方法として、次の反応式で表される方法が用いられる。

式中Ri~Riiは、水素原子もしくは置換基を 表す。

本発明におけるこのような製造方法においては
活性な塩素の攻撃を受けることがないので、フタ
ロシアニン核の塩素化を完全に回避することがで
きる。又従来の四塩化チタンを用いる方法に比べ
て反応性が高く、より穏やかな環境下で反応を進
行させることがでるため製造条件にとって有利で
あるばかりでなく、副反応を防止し不鈍物を最小

-11-

- (13) i C, H, OTi (OC, H, NHC, H, NH,),
- (14) (C₄H₁₇O)₄Ti[P(OC₁₅H₂₇)₂]₂ OH
- (15) $[(CH_2 CHCH_2OCH_2)_2(C CH_2O)]_T i [P(OC_1_2H_2_7)_2]_3$ $C_2H_5 OH$

$$(16) \begin{array}{c} 0 = 0 \\ CH_2 = 0 \\ CH_3 \end{array} \qquad \left(\begin{array}{c} 0 = 0 \\ CH_3 \\ CH_3 \end{array} \right)$$

に抑えることができるもである。

本反応において有用なチタン化合物の具体例を 次に示す。

- (1) (C.H.O).Ti
- (2) (i-C,H,0),Ti
- (3) (C₂H₂O)₄Ti
- (4) (i-C.H.O).Ti
- (5) (C, H, 70) Ti
- (6) (C,H,O),Ti
- (7) $(i-C_3H_7O)_2Ti(CH_2COCHCOCH_3)_3$
- . (8) (HOCOCHO)₂Ti(OH)₂ CH₃

(10) (C₄H₁,0)₄Ti[P(OC₃H₇)₂]₂ OH

-12-

(19)
$$i - C_2H_7OTi(OCC_{17}H_{25})_3$$

反応の符集としては種々のものを用いることがの能である。例えばジオキサン、シクロペキサルホルホキシド、メチルホルホキシド、メチルボントアミド、メチルベンロルベンゼン、ニトロベンゼン、ロルナフタロン、テトラリン、はないとしてある程度の作用である。 には 新生 はいのが 望ましい。

反応温度は、チタンカップリング剤の種類によって異なるが、だいたい100~180℃で行うことができる。この点でも従来の反応が180~240℃という

高温を必要としていたのだ対して、副反応防止という観点から有利である。

こうして得られた高純度のチタニルフタロシアニンは適当な溶媒で処理することによって、目的の結晶型を得ることができが、処理に用いられる装置としては一般的な撹拌装置の他に、ホモミキサー、デイスパイザ、アジター、或いはポールミル、サンドミル、アトライタ等を用いることができる。

本発明の電子写真感光体において、上記のチタニルフタロンアニンはキャリア発生物質として用いられるが、その他に、他のキャリア発生物質を付用してもよい。そのようなキャリア発生物質としては本発明とは結晶型において異なるチタニルマタロシアニンをはじめ、他のフタロシアニン顔料、アゾ顔料、アントラキノン顔料、ペリレン顔料、多環キノン顔料、スクェアリウム顔料等が挙げられる。

本発明の感光体におけるキャリア輸送物質としては、種々のものが使用できるが、代表的なもの

-15-

T - 2

T - 3

T - 4

T - 5

-17-

としては例えば、オキサゾール、オキサジアゾール、チタゾール、チアジアゾール、イミダゾール等に代表される含窒素複素環核及びその縮合環核を有する化合物、ポリアリールアルカン系の化合物、ピラゾリン系化合物、ヒドラゾン系化合物、トリアリールアミン系化合物、スチリルトリフェニルアミン系化合物、β-フェニルスチリルトリフェニルアミン系化合物、ブタジェン系化合物、ヘキサトリエン系化合物、カルバゾール系化合物、縮合多環系化合物等が挙げられる。これらのキャリア輸送物質の具体例としては、例えば特別昭61-107356号に配載のキャリア

輸送物質を挙げることができるが、特に代表的な

T - 1

ものの構造を次に示す。

- 16 -

T - 6

$$\bigcap_{\substack{N \\ N=CH}} \bigcap_{\substack{C_2H_4}} C_2H_4$$

T - 7

7-8

$$C_2H_5$$
 N CH= CH CH $-N$ C_2H_5

T - 9

T-11

T-12

$$C=CH-N$$

T-18

T-19

感光体の構成は種々の形態が知られている。本 発明の感光体はそれらのいずれの形態をもとりう 積層型もしくは分散型の機能分離型感光体 とするのが望ましい。この場合、通常は第1図か **ら第6図のような構成となる。第1図に示す層構** 成は、導電性支持体 1 上にキャリア発生層 2 を形 成し、これにキャリア輸送層3を積層して感光層 4 を形成したものであり、第2図はこれらのキャ

T - 14

T-15

$$C = CH - CH = C$$

$$C_2H_6$$

$$C_2H_6$$

$$C_3H_6$$

T-17

である。

リア発生層2とキャリア輸送層3を逆にした感光 層 4 ′を形成したものである。第3図は第1図の 層構成の感光層4と導電性支持体1の間に中間層 5 を設け、第 4 図は第 2 図の層構成の感光層 4 ′ と導電性支持体1との間に中間層5を設けたもの である。第5図の層構成はキャリア発生物質6と キャリア輸送物質7を含有する感光層4″を形成 したものであり、第6図はこのような感光層4″ と導電性支持体1との間に中間層5を設けたもの

第1図~第6図の構成において、最表層には、 更に、保護層を設けることができる。

感光層の形成においては、キャリア発生物質或 はキャリア輪送物質を単独で、もしくはパインダ や添加剤とともに溶解させた溶液を盤布する方法 が有効である。しかし又、一般にキャリア発生物 質の密解度は低いため、そのような場合キャリア 発生物質を超音波分散機、ポールミル、サンドミ ホモミキサー等の分散装置を用いて適当な分 散媒中に微粒子分散させた液を強布する方法が有 効となる。この場合、パインダや添加剤は分散液中に添加して用いられるのが通常である。

キャリア発生層もしくはキャリア輸送層の形成にバインダを用いる場合に、バインダとして任意のものを選ぶことができるが、特に 疎水性 でかつフィルム形成能を有する高分子重合体が望ましい。このような重合体としては例えば次のものを挙げることができるが、これらに限定されるものでは

- 23 -

0.05~ 5 д m が 好 ま し い 。 キ ャ リ ア 輪 送 層 の 厚 み は 1 ~ 100 д m で あ る が 、 更 に は 5 ~ 30 д m が 好 ま し い 。

上記感光層には感度の向上や残留電位の減少、 或いは反復使用時の疲労の低減を目的として、電 子受容性物質を含有させることができる。このよ うな電子受容性物質としては例えば、無水琥珀酸、 無水マレイン酸、ジブロム無水琥珀酸、無水フタ ル酸、テトラクロル無水フタル酸、テトラプロム 無水フタル酸、3-二トロ無水フタル酸、4-二ト 口無水フタル酸、無水ピロメリット酸、無水メリッ 卜敵、テトラシアノエチレン、テトラシアノキノ ジメタン、0-ジニトロペンゼン、=-ジニトロペン ゼン、1.3.5-トリニトロベンゼン、p-ニトロベン ゾニトリル、ピクリルクロライド、キノンクロル イミド、クロラニル、プロマニル、ジクロルジシ アノ-p-ベンゾキノン、アントラキノン、ジニト ロアントラキノン、g-フルオレニリデンマロノジ ニトリル、ポリニトロ-9-フルオレニリデンマロ ノジニトリル、ピクリン酸、 o-ニトロ安息番酸、

ない。

ボリカーボネート ボリカーボネート 2樹脂 アクリル樹脂 メタクリル樹脂 ボリ塩化ビニル ボリ塩化ビニリデン ボリスチレン スチレン-ブタジエン共重合体 ボリ酢酸ビニル ポリビニルホルマール ボリビニルブチラール ポリビニルアセタール ボリビニルカルパゾール スチレン-アルキッド 樹脂

シリコーン 樹脂 シリコーン-アルキッド 樹脂 ボリエステル フェノール 樹脂 ボリウレタン エボキシ 樹脂 塩化 ビニリデン-アクリロニトリル共重合体 塩化 ビニル - 酢酸 ビニル共重合体

塩化ビニル-酢酸ビニル-無水マレイン酸共重合体 パインダに対するキャリア発生物質の割合は10~600wt%が望ましく、更には50~400wt%が好ま しい。パインダに対するキャリア輸送物質の割合 は10~500wt%とするのが望ましい。キャリア発 生層の厚さは、0.01~20μmとされるが、更には

-24 -

p-ニトロ安息香酸、3.5-ジニトロ安息香酸、ペンタフルオロ安息香酸、5-ニトロサリチル酸、3.5-ジニトロサリチル酸、3.5-ジニトロサリチル酸、フタル酸、メリット酸、その他の電子親和力の大きい化合物を挙げることができる。電子受容性物質の添加割合はキャリア発生物質の重量100に対して0.01~200wt/wtが超ましく、更には0.1~100wt/wtが好ましい。

ミン化合物、などが有効である。特に有効な化合物の具体例としては、「IRGANOX 1010」、「IRGANOX 565」(チバ・ガイギー社製)、「スミライザー BHT」、「スミライザー NDP」(住友化学工業社製)等のヒンダードフェノール化合物、「サノール LS-2626」、「サノール LS-622LD」(三共社製)等のヒンダードアミン化合物が挙げられる。

中間層、保護層等に用いられるパインダを間間は、上記のキャリア発生層及びキャリア輸送層間に に挙げたものを用いることができるが、その他にポリアミド樹脂、エチレン-酢酸ビニル-無水マレイン酸共宜合体、エチレン-酢酸ビニル-メタクリル酸共宜合体等のエチレン系樹脂、ポリビニルアルコール、、セルース・サーン系樹脂、ポリビニルアルコール、、エチース・サーン・カート等の熱硬化或いは化学のできる。

導電性支持体としては、金属版、金属ドラムが 用いられる他、導電性ポリマーや酸化インジウム

-27-

第7図に示す X線回折スペクトルをもつ結晶型と した。

合成例 2

1.3-ジイミノイソインドリン; 29.2gと a -クロルナフタレン; 200m2を混合し、チタニウムテトラブトキシド; 20.4gを加えて窒素雰囲気下に140~1 50℃で 2 時間加熱し、続いて180℃で 3 時間反応させた。放冷した後折出物を瀘取し、スルホランで洗浄、次いでクロロホルムで洗浄し、更に 2 %-塩酸水溶液で洗浄、水洗、最後にメタノール洗浄して、乾燥の後26.2g(91.0%)のチタニルフタロシアニンを得た。元素分析における塩素含有量の値は0.08 vt%であった。

生成物は20倍量の濃硫酸に溶解し、100倍量の水にあけて折出させて、遮取した後に乾燥して、 第8図に示すX線回折スペクトルをもつ結晶型と した。

合成例3

合成例 1 で得たチタニルフタロシアニン:1.2g と後述の比較合成例 1 で得たチタニルフタロシア 等の夢電性化合物、もしくはアルミニウム、パラジウム等の金属の薄層を強布、蒸着、ラミネート 等の手段により紙やプラスチックフィルムなどの 基体の上に設けたものを用いることができる。

本発明の感光体は以上のような構成であって、以下の実施例からも明らかなように、帯電特性、感度特性、繰返し特性に優れたものである。
(実施例)

次に本発明における具体的な実施例を示す。 合成例 l

1.3-ジイミノイソインドリン;29.2gとスルホラン;200m2を混合し、チタニウムトライソプロポキシド;17.0gを加え、窒素雰囲気下に140℃で2時間反応させた。放冷した後折出物を離取し、クロロホルムで洗浄、2%-塩酸水溶液で洗浄、水洗、メタノール洗浄して、乾燥の後25.5g(88.8%)のチタニルフタロシアニンを得た。元素分析法において塩素は検出限界以下であった。

生成物は20倍量の機硫酸に溶解し、100倍量の水にあけて折出させて、濾取した後に乾燥して、

- 28 -

ニン;0.8gを40gの濃硫酸に溶かし、400gの水にあけて析出させて濃取し、乾燥して、塩素含有量0.19 wt%の本発明のチタニルフタロシアニンを得た。比較合成例(1)

フタロジニトリル: 25.6gと a - クロルナフタレン: 150m2の混合物中に窒素気流下で6.5m2の四塩化チタンを滴下し、200~2?0℃の温度で5時間反応させた。折出物を譲取し、a - クロルナフタレンで洗浄した後、クロロホルムで洗浄し、続いてメタノールで洗浄した。次いでアンモニア水中で選流して加水分解を完結させた後、水洗、メタノール洗浄し乾燥の後、チタニルフタロシアニン: 21.8g (75.6%)を得た。元素分析による塩素の含有量は0.46wt%であった。

生成物は10倍量の濃硫酸に溶解し、100倍量の水にあけて析出させて、濾取した後に乾燥して、第9図に示すX線回折スペクトルをもつ結晶型とした。

比較合成例(2)

合成例 1 で得たチタニルフタロシアニン; 0.6g

-30-

と比較合成例(1)で得たチタニルフタロシアニン:1.4gを40gの機硫酸に溶かし、400gの水にあけて 折出させて適取し、乾燥して、第10図に示す X線 回折スペクトルをもつ結晶型とした。この場合の・ 元素分析による塩素含有量は0.31vt%であった。 比較合成例(3)

フタロジニトリル; 25.6gに代えて、フタロジニトリル; 24.7gと 4-クロルフタロジニトリル; 1.0g
の混合物を用いた他は比較合成例 1 と同様にして、 塩素含有量 1.14vt % の比較用のチタニルフタロシアニンを得た。

実施 例 1

合成例1において得られた第7図のX線回折パターンを有するチタニルフタロシアニン;1部、パインダ樹脂としてシリコーン変性樹脂、「KR-5240」(信態化学社製);0.5部、分散媒としてイソプロパノール;100部をサンドミルを用いて分散し、これをアルミニウムを蒸着したポリエステルベース上にワイヤバーを用いて強布して、誤厚0.4μmのキャリア発生層を形成した、次いで、キャリア輸送物

-31 -

タン:10部に溶解した液を浸渍整布法によって数布して、乾燥の後、膜厚23μ mのキャリア輸送層を形成した。

このようにして得られた感光体をサンプル2とする。

安施例3

実施例2における、第7図のチタニルフタロシアニンを合成例3で得たチタニルフタロシアニンに代えた他は実施例2と同様にして感光体を作成した。これをサンブル3とする。

比較例(1)

実施例 2 における、第 7 図のチタニルフタロシアニンを比較合成例(1)で得た、第 9 図の X線回折パターンを持つ比較のチタニルフタロシアニンに代えた他は実施例 1 と同様にして比較用の感光体を得た。これを比較サンブル(1)とする。比較例(2)

実施例 2 における、第 7 図の チ タニル フ タ ロ シアニンを比較合成例(2)で得た、第 10 図の X 線回 折パターンを持つ比較のチタニル フ タ ロ シアニン 質 T-3:1部とボリカーボネート樹脂「ユービロン Z200」(三菱 互斯化学社製):1.3部、及び 抵加剤として、「サノール LS-2626」(三共社製)0.03部、微量のシリコーンオイル「KF-54」(信越化学社製)を、1,2-ジクロルエタン:10部に溶解した液をブレード量布機を用いて強布し乾燥した後、膜厚18μ■のキャリア輸送層を形成した。このようにして得られた感光体をサンブル1とする。

実施例2

合成例 2 で得た第 8 図のチタニルフタロシアニン; 1 部、分散媒としてクロロホルム; 100部を超音波分散装置を用いて分散した。一方、アルミニウムを蒸着したポリエステルベース上にポリアミド樹脂「CN8000」(東レ社製)からなる厚さ0.2μmの中間層を設け、その上に、先に得られた分散液を浸透塗布法によって塗布して、膜厚0.3μmのキャリア発生層を形成した。次いでキャリア輸送物質T-2; 1 部とポリカーポネート樹脂「パンライト K-1300」(帝人化成社製); 1.3部及び微量のシリコーンオイル「KF-54)(信館化学社製)を1,2-ジクロエ

- 32 -

に代えた他は実施例2と同様にして比較用の感光 体を得た。これを比較サンブル(2)とする。 比較例(3)

実施例2における、第7図のチタニルフタロシアニンを比較合成例(3)で得た、比較用のチタニルフタロシアニンに代えた他は実施例2と同様にして比較用の感光体を得た。これを比較サンブル(3)とする。

(評価 1)

以上のようにして得られたサンブルは、ペーパアナライザ EPA-8100(川口電気社製)を用いて、以下のような評価を行った。まず、-80μAの条件で5秒間のコロナ帯電を行い、帯電直後の表面電位 Viを求め、銃いで表面無度が 2 (1 ux)となるような露光を行い、表面電位を 1 / 2 Viとするのに必要な露光量 E 1/2を求めた。又D=100(Va-Vi)/Va(%)の式より暗波表率Dを求めた。結果は表1に示した。塩素含有量の低下により、特に電位保持能に優れた特性が得られる。

サンブル名	塩業含有量	Va	Vi	D	E1/2
	(%)	. (Y)	(V)	(%)	(Luxsec)
サンプルー	0	-1170	- 860	26.5	1.25
サンブル2	0.08	-1060	-770	27 4	1.30
サンブル3	0.19	-1020	-730	28.4	1.30
比較サンプル(1)	0.46	- 950	-640	31.6	1.42
比較サンブル(2)	0.31	- 950	-650	32.6	1.45
比較サンブル(3)	1.14	- 900	-610	32.2	1.44

4. 図面の簡単な説明

第1 図~第6 図は本発明の感光体の層構成の具 体例を示した各断面である。

第7図及び第8図は本発明に係るチタニルフタ ロシアニンのX線回折図、第9図及び第10図比較合 皮例において得られるチタニルフタロシアニンの X線回折図である。

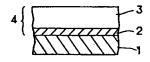
1 … 導電性支持体

3 … キャリア輪送暦

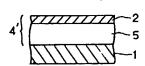
5 … 中間層

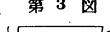
-35-

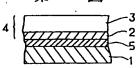


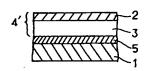


第 2 図

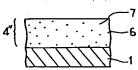




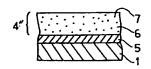




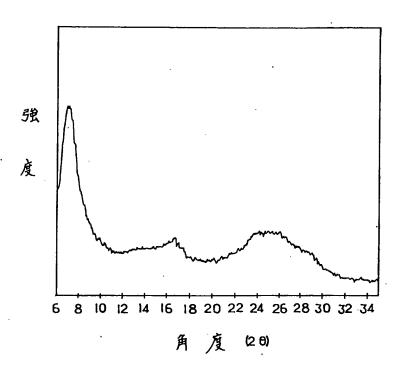
第 5 図



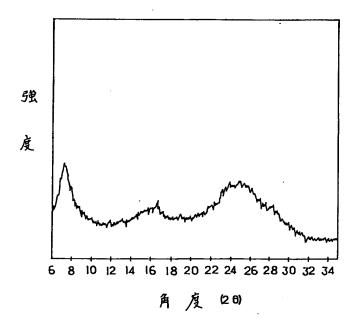
第 6 図



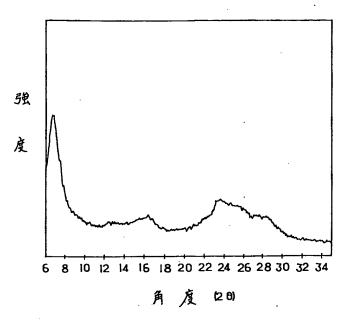
第 7 図



第 8 図



第 9 図



第 10 図

